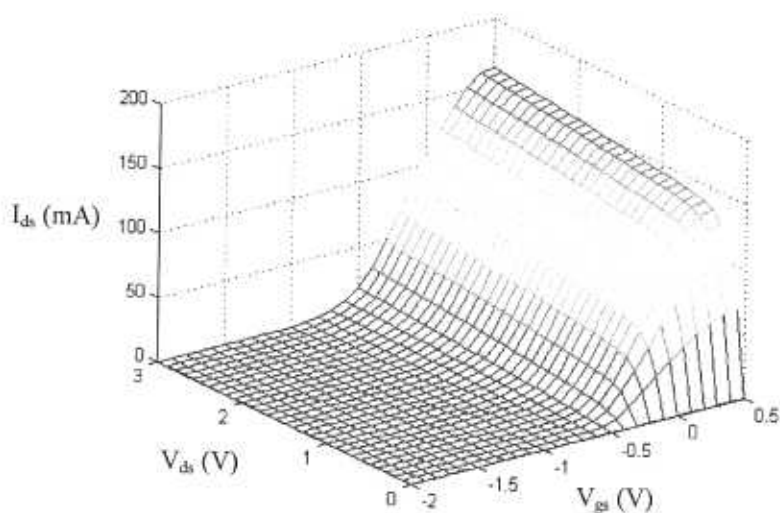


-0.1	80.8819	81.7584	82.6251	83.4822	84.33	85.1685	85.998	86.8187	87.6308	88.4344
0	100.0827	100.9727	101.8527	102.7229	103.5836	104.4349	105.2771	106.1104	106.9349	107.7509
0.1	117.3728	118.2687	119.1546	120.0307	120.8971	121.7542	122.602	123.4409	124.2709	125.0923
0.2	132.0674	132.9659	133.8544	134.7331	135.602	136.4616	137.3119	138.1532	138.9857	139.8095
0.3	144.0674	144.9671	145.8567	146.7365	147.6066	148.4672	149.3186	150.161	150.9945	151.8194
0.4	152.8513	153.7515	154.6416	155.5219	156.3924	157.2536	158.1054	158.9483	159.7823	160.6076
0.5	154.4813	155.3818	156.2721	157.1525	158.0233	158.8846	159.7367	160.5797	161.4139	162.2394

Valores de I_{ds} para valores de V_{gs} entre -2 y 0.5 y valores de V_{ds} entre 2.1 y 3.1

Si representamos estos datos gráficamente, se puede observar mejor el comportamiento del transistor a modelar:



Tras proceder de la misma manera que en el apartado anterior, obtenemos un error cuadrático medio de 5.1102 y los siguientes valores para los parámetros del modelo en estudio:

I_o	$p1$	$q1$	$Vp1$	α
78.5463	2.7753	0.1474	0.0147	4.7323

Con lo que finalmente queda la siguiente expresión:

$$I_{ds} = 78.5463 \cdot [1 + \tanh(2.7753 \cdot V_{gs} + 0.1474 \cdot V_{ds} - 0.0147)] \cdot [\tanh(4.7323 \cdot V_{ds})]$$

A continuación se muestra la representación gráfica de los resultados obtenidos: